

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成19年10月25日(2007.10.25)

【公開番号】特開2001-142224(P2001-142224A)

【公開日】平成13年5月25日(2001.5.25)

【出願番号】特願2000-258450(P2000-258450)

【国際特許分類】

<i>G 03 F</i>	7/20	(2006.01)
<i>G 09 F</i>	9/00	(2006.01)
<i>H 01 L</i>	27/08	(2006.01)
<i>G 02 F</i>	1/1368	(2006.01)
<i>H 01 L</i>	21/027	(2006.01)
<i>H 01 L</i>	21/8238	(2006.01)
<i>H 01 L</i>	27/092	(2006.01)
<i>H 01 L</i>	21/336	(2006.01)
<i>H 01 L</i>	29/786	(2006.01)

【F I】

<i>G 03 F</i>	7/20	5 0 1
<i>G 09 F</i>	9/00	3 4 2 Z
<i>H 01 L</i>	27/08	3 3 1 E
<i>G 02 F</i>	1/1368	
<i>H 01 L</i>	21/30	5 1 4 A
<i>H 01 L</i>	27/08	3 2 1 F
<i>H 01 L</i>	27/08	3 2 1 N
<i>H 01 L</i>	29/78	6 1 2 D
<i>H 01 L</i>	29/78	6 1 2 B

【手続補正書】

【提出日】平成19年8月27日(2007.8.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被加工物を基板上に形成し、
 前記被加工物上にレジストを塗布し、
 前記レジストに第1の露光手段によって第1のパターンを形成し、
 前記第1のパターンの一部に、前記第1の露光手段と異なる第2の露光手段によって第2のパターンを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項2】

被加工物を基板上に形成し、
 前記被加工物上にレジストを塗布し、
 前記レジストの第1の領域と第2の領域を第1の露光手段によって露光して、前記第1の領域と前記第2の領域との間に第1のパターンを形成し、
 前記第1のパターンの一部である第3の領域と第4の領域を、前記第1の露光手段と異なる第2の露光手段によって露光して、前記第3の領域と前記第4の領域との間に第2のパターンを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項3】

被加工物を基板上に形成し、
前記被加工物上にレジストを塗布し、
前記レジストに第1の露光手段によって第1のパターンを形成し、
前記第1のパターンの一部に、前記第1の露光手段と異なる第2の露光手段によって第2のパターンを形成し、
前記第1の露光手段における解像度と前記第2の露光手段における解像度が異なることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項4】

被加工物を基板上に形成し、
前記被加工物上にレジストを塗布し、
前記レジストの第1の領域と第2の領域を第1の露光手段によって露光して、前記第1の領域と前記第2の領域との間に第1のパターンを形成し、
前記第1のパターンの一部である第3の領域と第4の領域を、前記第1の露光手段と異なる第2の露光手段によって露光して、前記第3の領域と前記第4の領域との間に第2のパターンを形成し、
前記第1の露光手段における解像度と前記第2の露光手段における解像度が異なることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項5】

請求項1乃至請求項4のいずれか一において、
前記第1の露光手段における露光範囲と前記第2の露光手段における露光範囲が異なることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項6】

請求項1乃至請求項5のいずれか一において、
前記第1の露光手段における露光装置と前記第2の露光手段における露光装置が異なることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項7】

請求項1乃至請求項6のいずれか一において、
前記第1の露光手段においてミラープロジェクションを用い、前記第2の露光手段においてステッパーを用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項8】

請求項1乃至請求項7のいずれか一において、
前記第1のパターンの最小線幅と前記第2のパターンの最小線幅が異なることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項9】

請求項1乃至請求項8のいずれか一において、
前記被加工物に、半導体膜、導電膜又は絶縁膜を用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項10】

請求項1乃至請求項9のいずれか一において、
前記基板に、石英基板、ガラス基板、プラスチック基板又は半導体基板を用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。